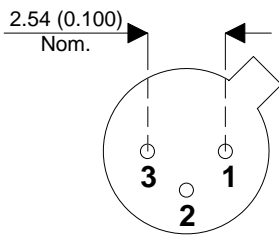
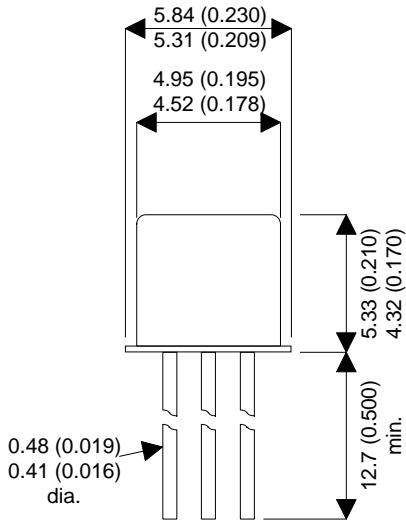




MECHANICAL DATA

Dimensions in mm (inches)



TO-18 (TO-206AA) PACKAGE

PIN 1 – Emitter PIN 2 – Base PIN 3 – Collector

HIGH VOLTAGE PNP SILICON TRANSISTOR

FEATURES

- Hermetic Metal Package
- Screening Options Available

APPLICATIONS:

All Semelab hermetically sealed products can be processed in accordance with the requirements of BS, CECC and JAN specifications

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated)

V_{CBO}	Collector – Base Voltage		-300V
V_{CEO}	Collector – Emitter Voltage		-300V
V_{EBO}	Emitter – Base Voltage		-5V
I_C	Continuous Collector Current		-0.5A
P_D	Total Device Dissipation	$T_A = 25^\circ\text{C}$	0.5W
		Derate above 25°C	2.86mW/ $^\circ\text{C}$
P_D	Total Device Dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	2.5W
		Derate above 25°C	14.3mW/ $^\circ\text{C}$
T_J, T_{STG}	Operating Junction & Storage Temperature Range		-65 to 200°C
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance, Junction – Case		70°C/W

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated)

Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit	
OFF CHARACTERISTICS						
$V_{(BR)CEO}$	Collector – Emitter Breakdown Voltage	$I_C = -10\text{mA}$ $I_B = 0$	-300		V	
$V_{(BR)CBO}$	Collector – Base Breakdown Voltage	$I_C = -100\mu\text{A}$ $I_E = 0$	-300			
$V_{(BR)EBO}$	Emitter – Base Breakdown Voltage	$I_E = 100\mu\text{A}$ $I_C = 0$	-6			
I_{CBO}	Collector Cut-off Current	$V_{CB} = -250\text{V}$ $I_E = 0$		-50	nA	
I_{CEO}	Collector Cut-off Current	$V_{CE} = -300\text{V}$ $I_B = 0$		-500		
I_{EBO}	Emitter Cut-off Current	$V_{BE} = -5\text{V}$ $I_C = 0$		-50		
ON CHARACTERISTICS						
h_{FE}	DC Current Gain	$V_{CE} = -1\text{V}$ $I_C = -1\text{mA}$	30	45	—	
		$V_{CE} = -10\text{V}$ $I_C = -10\text{mA}$	35	50		
		$V_{CE} = -10\text{V}$ $I_C = -30\text{mA}$	35	55		150
		$V_{CE} = -10\text{V}$ $I_C = -100\text{mA}$		40		
$V_{CE(sat)}$	Collector – Emitter Saturation Voltage	$I_C = -10\text{mA}$ $I_B = -1\text{mA}$		-0.15	-0.3	V
		$I_C = -30\text{mA}$ $I_B = -3\text{mA}$		-0.25	-0.4	
$V_{BE(sat)}$	Base – Emitter Saturation Voltage	$I_C = -10\text{mA}$ $I_B = -1\text{mA}$			-0.8	V
		$I_C = -30\text{mA}$ $I_B = -3\text{mA}$			-0.9	
DYNAMIC CHARACTERISTICS						
f_T	Current Gain Bandwidth Product	$I_C = -20\text{mA}$ $V_{CE} = -20\text{V}$ $f = 20\text{MHz}$	50	110	200	MHz
C_{ob}	Output Capacitance	$I_E = 0$ $V_{CB} = -20\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$		3.5		pF
C_{ib}	Input Capacitance	$I_C = 0$ $V_{EB} = -0.5\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$		45		
t_{on}	Turn-On Time	$I_{B1} = -10\text{mA}$ $I_C = -50\text{mA}$ $V_{CC} = -100\text{V}$		100		ns
t_{off}	Turn-Off Time	$I_{B2} = -10\text{mA}$ $I_C = -50\text{mA}$ $V_{CC} = -100\text{V}$		400		

* Pulse Test: $t_p \leq 300\mu\text{s}$, $d \leq 2\%$.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TT Electronics:](#)

[BSS76](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.